

产品介绍

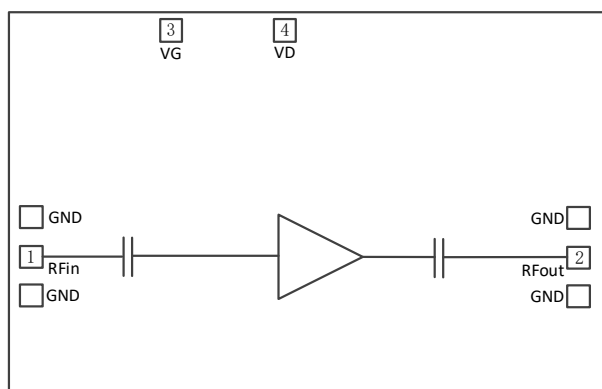
YLN199-0018B1 是一款性能优良的低噪声放大器芯片，频率范围覆盖 0.8~18GHz，具有高功耗和低功耗两种工作模式。高功耗模式下，小信号增益 17dB，噪声系数 1.5dB，输出 1dB 压缩功率 17dBm；低功耗模式下，小信号增益 16.5dB，噪声系数 1.3dB，输出 1dB 压缩功率 16dBm，饱和输出功率 17dBm。

该芯片采用了片上通孔金属化工艺，保证良好接地，不需要额外的接地措施，使用简单方便。芯片背面进行了金属化处理，适用于共晶烧结或导电胶粘接工艺。

关键技术指标

- 频率范围：0.8-18GHz
- 小信号增益：16.5dB@低功耗
- 噪声系数：1.4dB@低功耗
- 输出1dB压缩功率：16dBm@低功耗
- 饱和输出功率：17dBm@低功耗
- 输入回波损耗：12dB@低功耗
- 输出回波损耗：13dB@低功耗
- 直流电压/静态工作电流：+5V/31mA@低功耗
- 芯片尺寸：1.50mm × 1.00mm × 0.10mm

功能框图



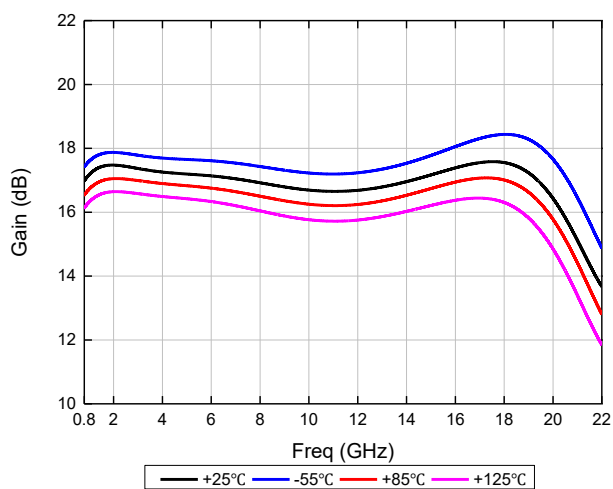
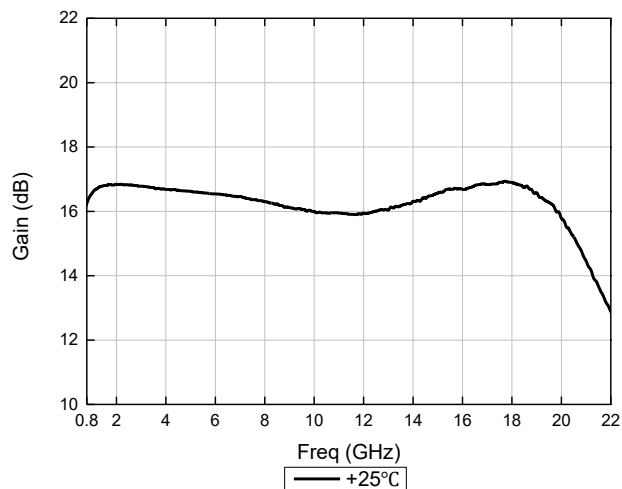
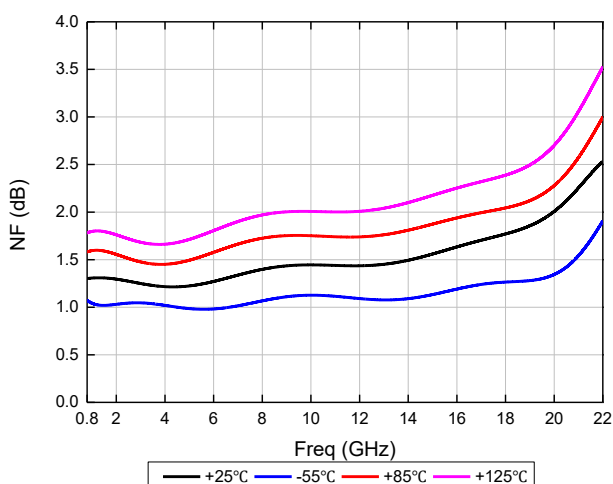
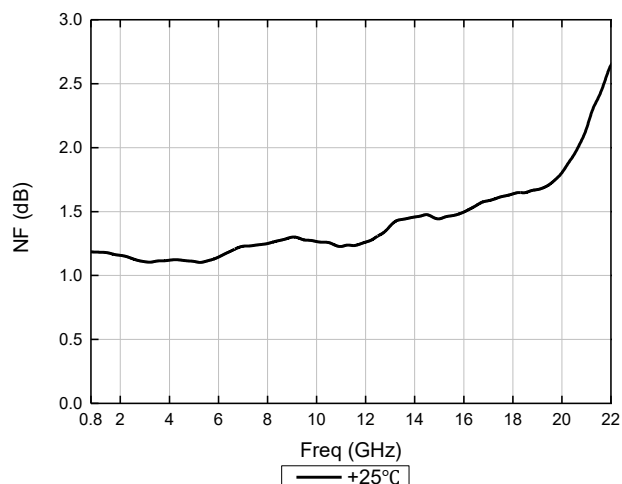
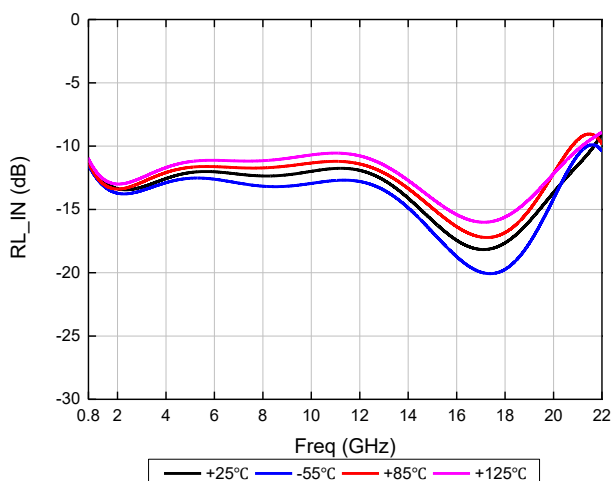
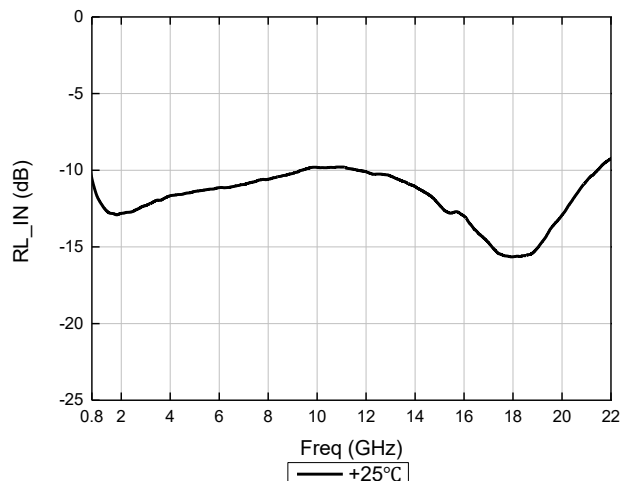
电性能表 (T_A=+25°C, VD=+5V)

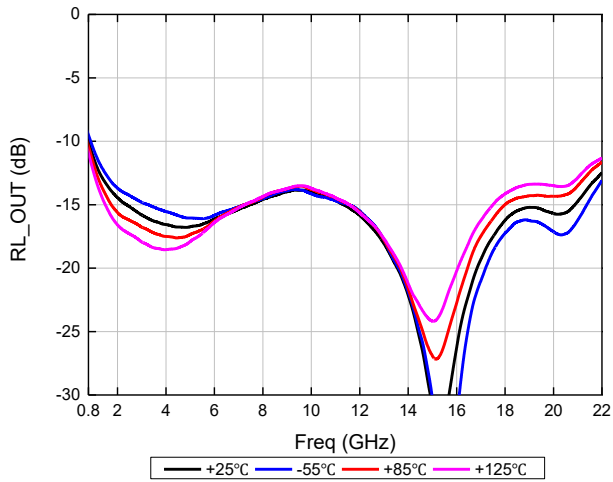
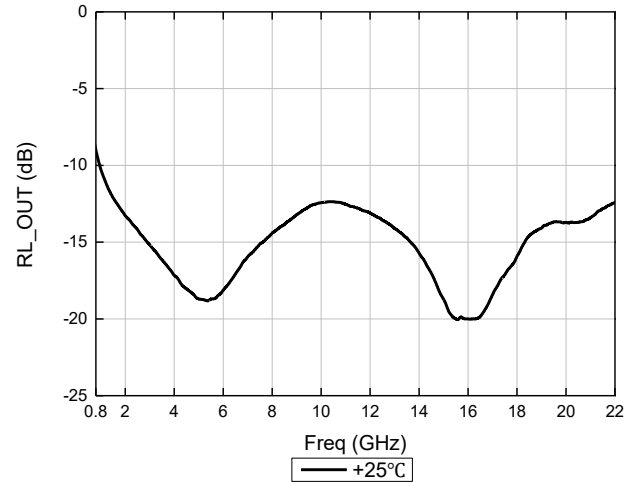
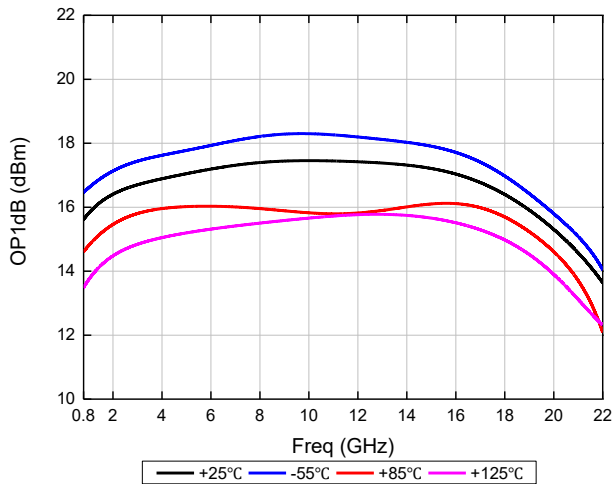
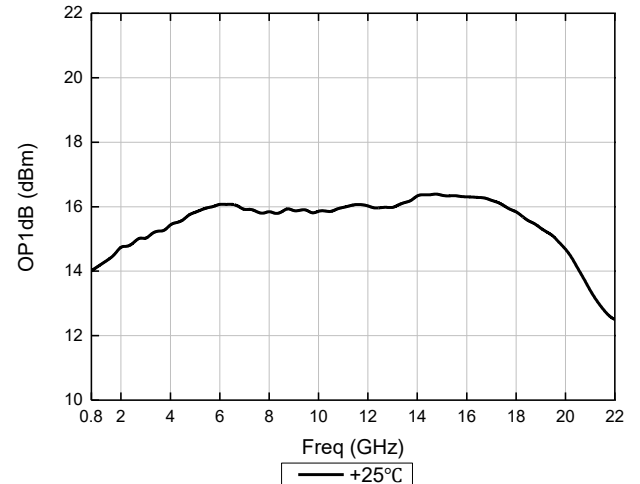
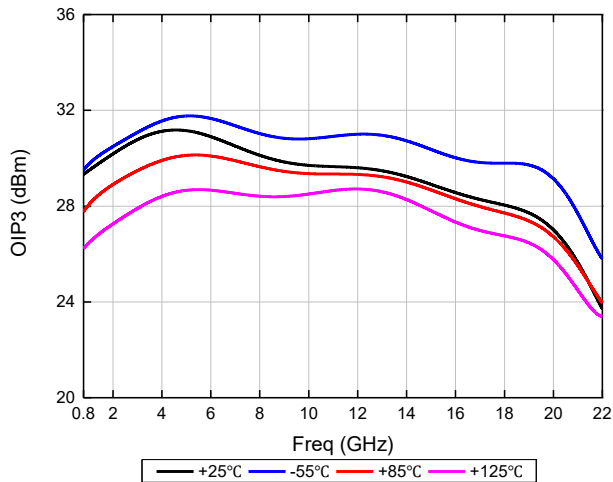
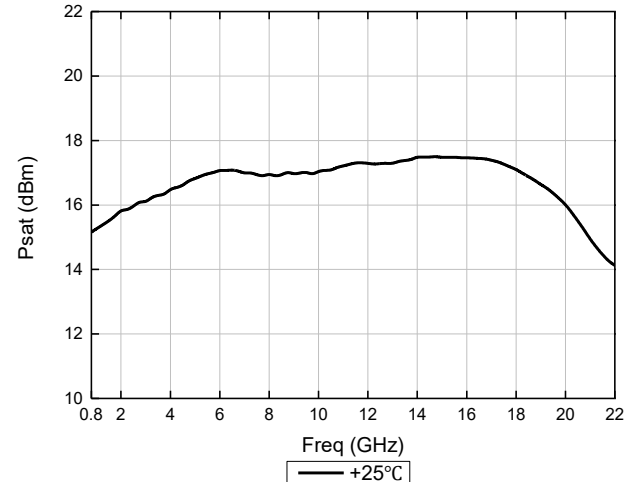
参数名称	符号	高功耗 (VG悬空)			低功耗 (VG接地)			单位
		最小值	典型值	最大值	最小值	典型值	最大值	
频率范围	Freq	0.8	—	18	0.8	—	18	GHz
小信号增益	Gain	16.5	17	—	16	16.5	—	dB
噪声系数	NF	—	1.5	1.8	—	1.3	1.7	dB
输出1dB压缩功率	OP1dB	15.5	17	—	14	16	—	dBm
饱和输出功率	Psat	—	—	—	15	17	—	dBm
输出三阶交调功率	OIP3	28	30	—	25	27	—	dBm
输入回波损耗	RL_IN	12	14	—	10	12	—	dB
输出回波损耗	RL_OUT	9	15	—	9	13	—	dB
静态工作电流	IDQ	—	45	—	—	31	—	mA

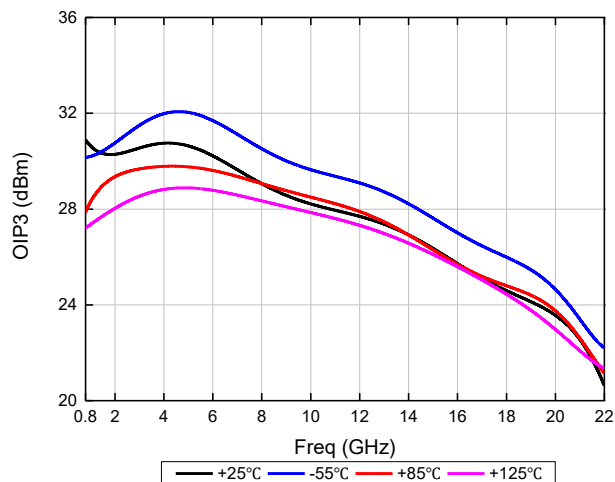
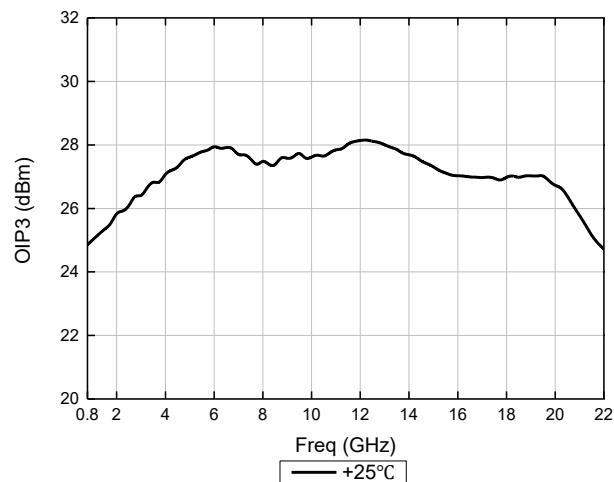
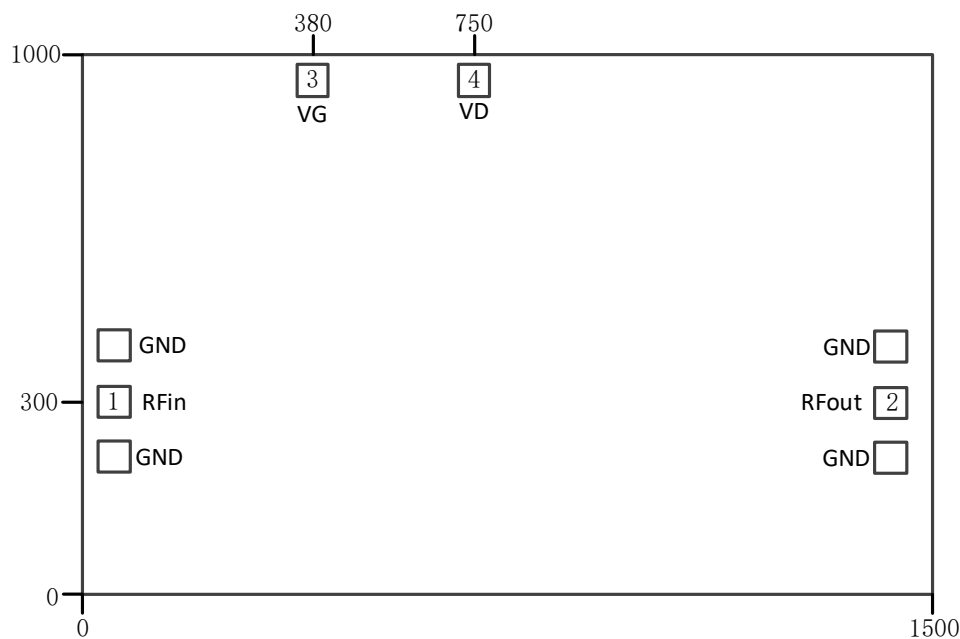
*测试条件：IDQ=31mA（低功耗），IDQ=45mA（高功耗）；OIP3 spacing=1MHz

使用限制参数

最大工作电压	+7V
最大输入功率	+30dBm
贮存温度	-65°C ~ +150°C
工作温度	-55°C ~ +125°C

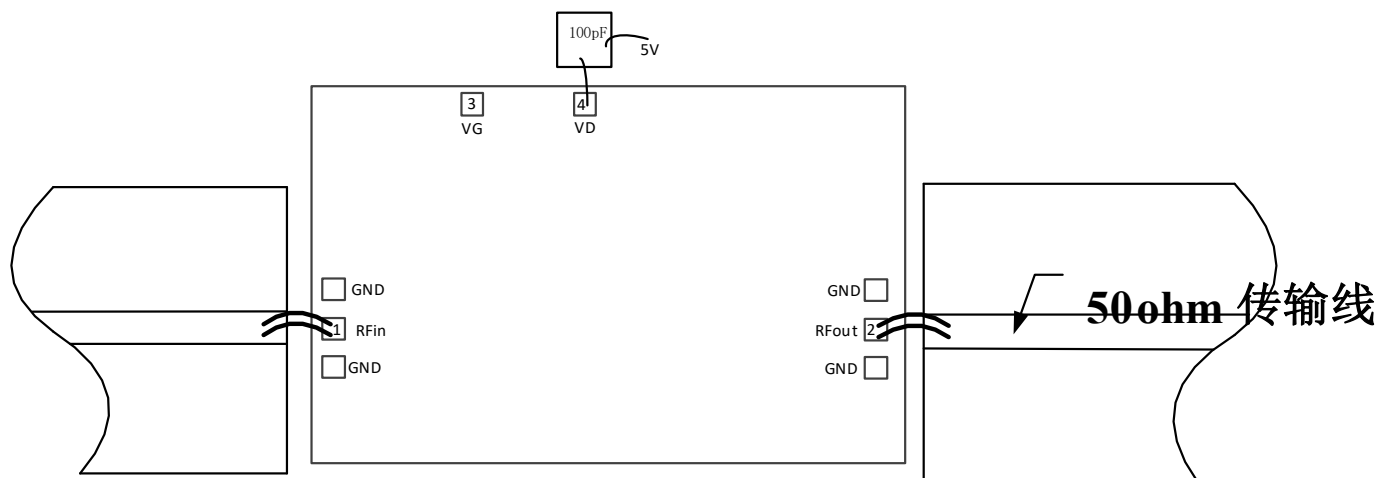
测试曲线
小信号增益@高功耗

小信号增益@低功耗

噪声系数@高功耗

噪声系数@低功耗

输入回波损耗@高功耗

输入回波损耗@低功耗


输出回波损耗@高功耗

输出回波损耗@低功耗

输出1dB压缩功率@高功耗

输出1dB压缩功率@低功耗

输出三阶交调功率 (Pin=-15dBm) @高功耗

饱和输出功率@低功耗


输出三阶交调功率（Pin=-20dBm）@高功耗

输出三阶交调功率（Pin=-12dBm）@低功耗

芯片端口图（单位：μm）

端口定义

序号	端口名	定义	信号或电压
1	RFin	射频信号输入端，集成隔直功能	RF
2	RFout	射频信号输出端，集成隔直功能	RF
3	VG	工作模式选择	悬空（高功耗模式） 接地（低功耗模式）
4	VD	直流电压	+5V
其他	/	GND	/

建议装配图



注意事项

- 1) 在净化环境装配使用；
- 2) GaAs 材料很脆，芯片表面很容易受损伤（不要碰触表面），使用时必须小心；
- 3) 输入输出用 2 根键合线（直径 25 μ m 金丝），键合线长度为 400 μ m 左右；
- 4) 烧结温度不要超过 300 $^{\circ}$ C，烧结时间尽可能短，不要超过 30 秒；
- 5) 本品属于静电敏感器件，储存和使用时注意防静电；
- 6) 干燥、氮气环境储存；
- 7) 不要试图用干或湿化学方法清洁芯片表面。